

Title (en)

Transition between a ridge wave guide and a planar circuit

Title (de)

Übergang zwischen einem Stegwellenleiter und einer ebenen Schaltung

Title (fr)

Transition entre un guide d'ondes à crête et un circuit planaire

Publication

EP 0834954 A1 19980408 (FR)

Application

EP 97401936 A 19970814

Priority

FR 9611941 A 19961001

Abstract (en)

The section has a number of contact points (33,34) which are formed preferably using a thermal compression machine. The contact points are used for positioning of a conductor (44). The planar circuit (30) is preferably of microstrip type. At least one conductive link (32) is coupled to the end of the conductor. The same access is used for both the contact points and the conductive link. A hermetic window is formed in the waveguide.

Abstract (fr)

L'invention concerne une transition entre un guide d'ondes à crête (10) et un circuit planaire (30) sur lequel est prévu un conducteur (44). La transition comporte au moins une liaison conductrice (32) reliant l'extrémité de la crête au conducteur (44) entre deux points de contact (33, 34). Selon l'invention, les points de contact (33, 34) sont en regard d'un même accès (35) prévu pour la mise en place de la liaison conductrice (32). Il est ainsi possible de réaliser industriellement ces points de contact (33, 34), à l'aide d'une machine à thermo-compression par exemple. <IMAGE>

IPC 1-7

H01P 5/107

IPC 8 full level

H01P 5/107 (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01P 5/107 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] US 4636753 A 19870113 - GELLER BERNARD D [US], et al
- [A] EP 0169048 A2 19860122 - NEC CORP [JP]
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 9, no. 81 (E - 307)<1804> 10 April 1985 (1985-04-10)
- [A] WILLIAMS D A: "MILLIMETER-WAVE COMPONENTS AND SUBSYSTEMS BUILT USING MICROSTRIP TECHNOLOGY", IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, vol. 39, no. 5, 1 May 1991 (1991-05-01), pages 768 - 774, XP000201471
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 8, no. 277 (E - 285)<1714> 18 December 1984 (1984-12-18)

Cited by

US8598966B2; US9368854B2; EP2201679B1

Designated contracting state (EPC)

DE ES FI GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0834954 A1 19980408; CA 2215480 A1 19980401; FR 2754108 A1 19980403; FR 2754108 B1 19981113; JP H10126116 A 19980515; NO 974484 D0 19970929; NO 974484 L 19980402; US 5969580 A 19991019

DOCDB simple family (application)

EP 97401936 A 19970814; CA 2215480 A 19970930; FR 9611941 A 19961001; JP 26901597 A 19971001; NO 974484 A 19970929; US 94167297 A 19970930